This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP11109356

Publication date:

1999-04-23

Inventor(s):

KOMA TOKUO; KOMURA TETSUJI; YONEDA KIYOSHI

Applicant(s)::

SANYO ELECTRIC CO LTD

Requested Patent:

☐ JP11109356

Application Number: JP19970268974 19971001

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/1337; G02F1/136

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve brightness, a visual angle characteristic, and an aperture ratio. SOLUTION: This device is a vertical orientation type liquid crystal display device which is provided with liquid crystal layers 40 having vertically oriented liquid crystal molecules 41 between plurally formed display electrodes 19 and counter electrodes 31, and controls the orientation of the liquid molecules 41 by an electric field. And, transparent auxiliary electrodes 50 for controlling the orientation of the liquid crystal molecules 41 are formed vertically or horizontally via an insulating layer 15 riding across the adjacent display electrodes 19, and further, orientation control windows 32 are formed in the horizontal or vertical direction on the side of the counter electrode 31 so as to be positioned at the center of the display electrode 19.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-109356

(43)公開日 平成11年(1999)4月23日

(51) Int.Cl.6		識別記号	FI		
G02F	1/1337	500	G 0 2 F	1/1337	500
	1/136	500		1/136	500

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

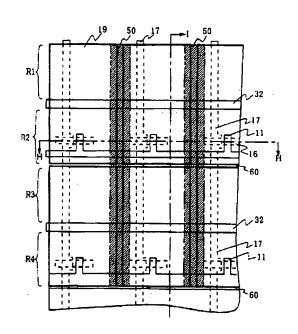
(21)出顧番号	特顧平 9-268974	(71)出願人 000001889
		三洋電機株式会社
(22)出顯日	平成9年(1997)10月1日	大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
		(72)発明者 小間 徳夫
		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
		洋電機株式会社内
		(72)発明者 小村 哲司
		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
		洋電機株式会社内
		(72)発明者 米田 清
		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
		洋電機株式会社内
	•	
	-	(74)代理人 弁理士 安富 耕二 (外1名)

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 輝度、視角特性、開口率を向上させる。

【解決手段】 複数形成された表示電極(19)と対向電極(31)との間に垂直配向された液晶分子(41)を有する液晶層(40)が設けられ、電界により液晶分子(41)の配向を制御する垂直配向方式の液晶表示装置であり、隣合う表示電極(19)を跨るように絶縁層(15)を介して液晶分子(41)の配向を制御するための透明の補助電極(50)が、垂直方向若しくは水平方向に形成され、更に、表示電極(19)の中央に位置するよう対向電極(31)側に水平方向もしくは垂直方向に配向制御窓(32)が形成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数形成された表示電極と対向電極との間に垂直配向された液晶分子を有する液晶層が設けられ、電界により上記液晶分子の配向を制御する垂直配向方式の液晶表示装置であって、

上記対向電板に配向制御窓が形成され、

上記表示電極間に表示電極と絶縁層を介して、電圧が印 加されない補助電極が形成されたことを特徴とする液晶 表示装置。

【請求項2】 複数形成された表示電極と対向電極との間に垂直配向された液晶分子を有する液晶層が設けられ、電界により上記液晶分子の配向を制御する垂直配向方式の液晶表示装置であって、

水平又は垂直のいずれか一方の方向の上記表示電極間に、表示電極と絶縁層を介して補助電極が形成され、上記対向電極側に、上記表示電極の略中央に位置し垂直又は水平のいずれか一方の方向に連続する配向制御窓が形成されたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】 上記補助電極は、透明電極であることを 特徴とする請求項1または2記載の液晶表示装置。

【請求項4】 上記補助電極には電圧が印加されていないことを特徴とする請求項2または3記載の液晶表示装置。

【請求項5】 上記補助電極は隣合う表示電極を跨るように形成されたことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶の電気光学的な異方性を利用して表示を行う液晶表示装置(LCD: Liquid CrystalDisplay)に関し、特に、輝度、視角特性並びに開口率の向上を達成した液晶表示装置に関する

[0002]

【従来の技術】LCDは、小型、薄型、低消費電力等の利点があり、OA機器、AV機器等の分野で実用化が進んでいる。特に、スイッチング素子として、薄膜トランジスタ(以下、TFTと略す)を用いたアクティブマトリクス型は、原理的にデューティー比100%のスタティック駆動をマルチプレクス的に行うことができ、大画面、高精細な動画ディスプレイに使用されている。

【0003】TFTは電界効果トランジスタであり基板上に行列状に配置され、液晶を誘電層とした画素容量の一方を成す表示電極に接続されている。TFTはゲートラインにより同一行について一斉にオン/オフが制御されると共に、ドレインラインより画素信号電圧が供給され、TFTがオンされた画素容量に対して行列的に指定された表示用電圧が充電される。表示電極とTFTは同一基板上に形成され、画素容量の他方を成す対向電極は、液晶層を挟んで対向配置された別の基板上に全面的

に形成されている。即ち、液晶及び対向電極が表示電極により区画されて表示画素を構成している。画素容量に充電された電圧は、次にTFTがオンするまでの1フィールド或いは1フレーム期間、TFTのオフ抵抗により絶縁的に保持される。液晶は電気光学的に異方性を有しており、画素容量に印加された電圧に応じて透過率が制御される。表示画素毎に透過率を制御することで、これらの明暗が表示画像として視認される。

【0004】液晶は、更に、両基板との接触界面に設け られた配向膜により初期配向状態が決定される。液晶と して例えば正の誘電率異方性を有したネマティック相を 用い、配向ベクトルが両基板間で90°にねじられたツ イストネマティック(TN)方式がある。通常、両基板 の外側には偏光板が設けられており、TN方式において は、各個光板の偏光軸は、夫々の基板側の配向方向に一 致している。従って、電圧無印加時には、一方の偏光板 を通過した直線偏光は、液晶のねじれ配向に沿う形で、 液晶層中で旋回し、他方の偏光板より射出され、表示は 白として認識される。そして、画素容量に電圧を印加し て液晶層に電界を形成することにより、液晶はその誘電 率異方性のために、電界に対して平行になるように配向 を変化し、ねじれ配列が崩され、液晶層中で入射直線偏 光が旋回されなくなり、他方の偏光板より射出される光 量が絞り込まれて表示は暫次的に黒になっていく。この ように、電圧無印加次に白を示し、電圧印加に従って黒 となる方式は、ノーマリー・ホワイト・モードと呼ば れ、TNセルの主流となっている。

【0005】図5及び図6に従来の液晶表示装置の単位 画素部分の構造を示す。図5は平面図、図6はその6-G線に沿った断面図である。基板(100)上に、C r、Ta、Mo等のメタルからなるゲート電極(10) 1)が形成され、これを覆ってSiNxまたは、及びS i O2等からなるゲート絶縁膜(102)が形成されて いる。ケート絶縁膜(102)上には、p-Si(10 3) が形成されている。p-Si(103) は、この上 にゲート電板(101)の形状にパターニングされたS "i O2等の注入ストッパー(104)を利用して、燐、 砒素等の不純物を低濃度に含有した(N-)低濃度(L D: Lightly doped) 領域(LD)、及び、その外側に 同じく不純物を高濃度に含有した(N+)ソース及びド レイン領域(S、D)が形成されている。注入ストッパ - (101)の直下は、実質的に不純物が含有されない 真性層であり、チャンネル領域(CH)となっている。 これら、p-Si(13)を覆ってSiNx等からなる 層間絶縁膜(105)が形成され、層間絶縁膜(10 5)上には、A1、Mo等からなるソース電極(10 6)及びドレイン電極(107)が形成され、各々層間 絶縁膜(105)に開けられたコンタクトホールを介し て、ソース領域(S)及びドレイン領域(D)に接続さ れている。このTFTを覆う全面には、SOG (SPIN 0 N GLASS)、B P S G (80R0-PH-OSPHO SILICATE GLAS S)、アクリル 樹脂等の平坦化絶縁膜(108)が形成されている。平坦化絶縁膜(108)上には、I T O (indium tin oxide)等の透明導電膜からなる液晶駆動用の表示電極(109)が形成され、平坦化絶縁膜(108)に開けられたコンタクトホールを介してソース電極(106)に接続されている。

【0006】これら全てを覆う全面には、ポリイミド等 の高分子膜からなる配向膜(120)が形成され、所定 のラビング処理により液晶の初期配向を制御している。 一方、液晶層を挟んで基板(100)に対向する位置に 設置された別のガラス基板(130)上には、ITOに より全面的に形成された対向電極(131)が設けら れ、対向電板(131)上にはポリイミド等の配向膜 (133)が形成され、ラビング処理が施されている。 【0007】ここでは、液晶(140)に負の誘電率異 方性を有したネマチック相を用い、配向膜(120、1 33)として垂直配向膜を用いたDAP(deformation of vertically aligned phase) 型を示した。DAP型 は、電圧制御視屈折(ECB: electrically controlle d birefringence) 方式の一つであり、液晶分子長軸と 短軸との屈折率の差、即ち、複屈折を利用して、透過率 を制御するものである。DAP型では、電圧印加時に は、直交配置された偏光板の一方を透過した入射直線偏 光を液晶層において、複屈折により楕円偏光とし、液晶 層の電界強度に従ってリタデーション量、即ち、液晶中 の常光成分と異常光成分の位相速度の差を制御すること で、他方の順光板より所望の透過率で射出させる。この 場合、電圧無印加状態から印加電圧を上昇させることに より、表示は黒から白へと変化していくので、ノーマリ ー・ブラック・モードとなる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】このように、液晶表示 装置では、所定の電極が形成された一対の基板間に装填 された液晶に所望の電圧を印加することで、液晶層中で の光の旋回或いは複屈折を制御することにより目的の透 過率或いは色扣を得、表示画像を作成する。即ち、液晶 の配向を変化してリタデーション量を制御することで、 TN方式においては透過光強度を調整できると共に、E ○B方式においては波長に依存した分光強度を制御して 色相の分離も可能となる。リタデーション量は、液晶分 子の長軸と電界方向とのなす角度に依存している。この ため、電界強度を調節することで、電界と液晶分子長軸 との成す角度が1次的に制御されても、観察者が視認す る角度、即ち、視角に依存して、相対的にリタデーショ ン量が変化し、視角が変化すると透過光強度或いは色相 も変化してしまい、いわゆる視角依存性の問題となって いた。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、これらの課題

を解決するために成され、複数形成された表示電極と対向電極との間に垂直配向された液晶分子を有する液晶層が設けられ、電界により上記液晶分子の配向を制御する垂直配向方式の液晶表示装置であって、上記対向電極に配向制御窓が形成され、上記表示電極間に表示電極と絶縁層を介して、電圧が印加されない補助電極が形成されたことを特徴とする構成である。

【0010】また、複数形成された表示電極と対向電極との間に垂直配向された液晶分子を有する液晶層が設けられ、電界により上記液晶分子の配向を制御する垂直配向方式の液晶表示装置であって、水平又は垂直のいずれか一方の方向の上記表示電極間に、表示電極と絶縁層を介して補助電極が形成され、上記対向電極側に、上記表示電極の略中央に位置し垂直又は水平のいずれか一方の方向に連続する配向制御窓が形成されたことを特徴とする構成である。

【0011】これによれば、配向不良を防止することにより、輝度及び視角特性を向上させることができる。また、上記補助電極は、透明電極であることを特徴とする構成であり、これによれば、開口率を向上することができる。

[0012]

【発明の実施の形態】図1及び図2に本発明の第1の実施の形態に係る液晶表示装置の一部の構造を示す。図1は平面図、図2Aは図1のH-H線に沿った断面図、図2Bは図1のI-I線に沿った断面図である。基板(10)上に形成されたTFTは従来例に示したp-SiTFTと同一の構成であるが、ここでは簡略化して示している。

【0013】基板(10)上に、Cr、Ta、Mo等のメタルからなるゲート電極(11)が形成され、これを漫ってSiNxまたは/及びSiO2等からなるゲート絶縁膜(12)が形成されている。ゲート絶縁膜(12)上にはp-Si(16)が形成され、中央が真性層のチャネル領域でその外側に不純物を注入してソース領域及びドレイン領域が形成されている。 p-Si(16)にはこれをを覆うように層間絶縁膜(15)が形成されており、ドレイン領域にドレイン電極(17)が接続されている。更に、ITO(indium tin oxide)等の透明導電膜からなる表示電極(19)が層間絶縁膜(15)に開けられたコンタクトホールを介してソース領域と接続されている。

【0011】これら全てを覆う全面には、ボリイミド等の高分子膜からなる配向膜(図示せず)が形成されている。一方、液晶層を挟んで基板(10)に対向する位置に設置された別のガラス基板(30)上には、ITOにより全面的に形成された対向電極(31)が設けられ、対向電極(31)上にはボリイミド等の配向膜(図示せず)が形成されている。本発明では、配向膜(図示せず)及び液晶(40)を、液晶分子(41)が垂直とな

るものが選定されている。

な状態となる。

【0015】木発明の特徴は、図1及び図2日に示され るように、対向電極(31)側に、表示電極(19)の ほぼ中央に位置し、水平方向の全ての表示電極に跨るよ うに水平方向に連続して配向制御窓(32)を設けたと ころにある。この配向制御窓(32)は、対向電極(3 1)の存在しない部分である。更に、図2A、Bに示さ れるように、ゲート絶縁膜(12)上に表示電極(1 9) と絶縁層(15)を介して、補助電極(50)を設 けたところにある。この補助電極は、図1の斜線で示す ように、表示電極間に垂直方向に連続して形成され、し かも隣り合う表示電極を跨ぐように形成されている。 【0016】この補助電極(50)には何ら電圧を印加 しておらず、このためフローティング状態にある。従っ て、図2Aに破線で示されるように、補助電極(50) 「は両隣の表示電極(19)と容量結合される。そこで、 この液晶パネルを水平ライン毎に反転して駆動する水平 ライン反転駆動か、もしくはフィールド毎に反転するフ ィールド反転駆動を行った場合、補助電極(50)には 容量結合された水平方向の両隣の表示電極(19)の電 圧のほぼ中間の電圧がかかることとなる。つまり、表示 電極が水平方向にあたかも連続して形成されているよう

【0017】ここで、図2Bに示すように、配向制御窓(32)と表示電極間(60)においては液晶分子(41)を傾斜させるほどの電界がかからないため、図示のようにそこでは垂直に液晶分子が配向する。しかしその周辺では図に点線で示すように電界が発生し、液晶分子はその長蛙を電界に直角な方向に配向制御され、更にこれらの液晶分子の傾斜が液晶の連続性によって内部の液晶にまで伝わるので、配向制御窓(32)と表示電極間(60)とで挟まれた領域R1,R2,R3,R4では、図2Bに示すように垂直方向からみれば、液晶の配向方向が交互に逆方向となる。

【0018】 方、図2Aに示すように水平方向から見ると、液晶分子は全て表示電極のエッジから配向制御窓(32)の方向へ傾斜することとなり、図から明らかなように配向方向が一様となる。上述したように、この例では、表示電極が水平方向にあたかも連続して形成されているような状態であるので、この一様な配向は水平方向の1ライン全てにわたって生ずる。つまり、R1、R2、R3、R4の各ライン全域にわたって液晶の配向は一様となる。従って、配向不良がなくなり、輝度及び視角特性が著しく向上する。

【0019】また、ここでは、補助電極 (50)をIT 〇等の透明電極で形成したので、1水平ラインがすべて連続する状態になり、開口率も大きく向上する。図3及び図4に本発明の第2の実施の形態に係る液晶表示装置の一部の構造を示す。図3は平面図、図4Aは図3のJーJ線に沿った断面図、図4Bは図3のK-K線に沿っ

た断面図である。

【0020】この形態では、補助電極(50)と配向制 御窓(32)の形成方向が先の例と逆になっている点が 異なる。即ち、図に示されるように、対向電極(31) 側に、表示電極(19)のほぼ中央に位置し、垂直方向 の全ての表示電極に跨るように垂直方向に連続して配向 制御窓(32)を設けている。更に、図4A、Bに示さ れるように、基板(10)上に表示電極(19)と絶縁 膜(12)及び絶縁層(15)を介して、補助電标(5 (1)を設けている。この補助電極は、図3の斜線で示す ように、表示電極間に水平方向に連続して形成され、し かも隣り合う表示電極を跨ぐように形成されている。 【0021】この補助電極(50)は、先の例と同様何 ら電圧が印加されておらず、フローティング状態にある ので、図 4 Aに点線で示されるように、補助電極(5) 0)は両隣の表示電極(19)と容量結合される。そこ で、この液晶パネルを垂直ライン毎に反転して駆動する 垂直ライン反転駆動か、もしくはフィールド毎に反転す るフィールド反転駆動を行った場合、補助電極(5()) には容量結合された垂直方向の両隣の表示電極(19) の電圧のほぼ中間の電圧がかかることとなる。つまり、 表示電極が垂直方向にあたかも連続して形成されている ような状態となる。

【0022】ここで、図4Aに示すように、配向制御窓(32)と表示電極間(60)においては液晶分子(41)を傾斜させるほどの電極がかからないため、図示のようにそこでは垂直に液晶分子が配向する。しかしその周辺では図に点線で示すように電界が発生し、液晶分子はその長軸を電界に直角な方向に配向制御され、更にこれらの液晶分子の傾斜が液晶の連続性によって内部の液晶にまで伝わるので、配向制御窓(32)と表示電極間(60)とで挟まれた領域C1,C2,C3,C4では、図4Aに示すように水平方向から見れば、液晶の配向方向が交互に逆方向となる。

【0023】一方、図4Bに示すように垂直方向から見ると、液晶分子は全て表示電極のエッジから配向制御窓(32)の方向へ傾斜することとなり、図から明らかなように配向方向が一様となる。上述したように、この例では 表示電極が垂直方向にあたかも連続して形成されているような状態であるので、この一様な配向は垂直方向の1ライン全てにわたって生ずる。つまり、C1、C2、C3、C4の各垂直ライン全域にわたって液晶の配向は一様となる。従って、配向不良がなくなり、輝度及び視角特性が著しく向上する。

【0024】また、ここでも、補助電極(50)を1T 〇等の透明電極で形成したので、1垂直ラインがすべて 連続する状態になり、開口率が大きく向上する。

[0025]

【発明の効果】以上の説明から明かなように、配向不良 を防止することにより、輝度及び視角特性を向上させる ことができ、また、補助電極を透明電極としたので、開口率を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態にかかる液晶表示装置の画素部の平面図である。

【図2】図1のH - H線並びに I - I 線に沿った断面図 である。

【図3】本発明の第2の実施の形態にかかる液晶表示装置の画素部の平面図である。

【図4】図1のJ-J線並びにK-K線に沿った断面図である。

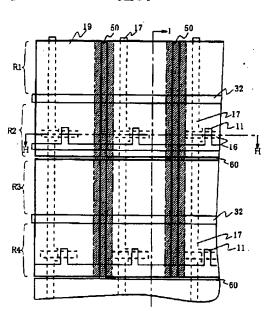
【図う】従来の液晶表示装置の単位画素部の平面図である

【図6】図3のG-G線に沿った断面図である。

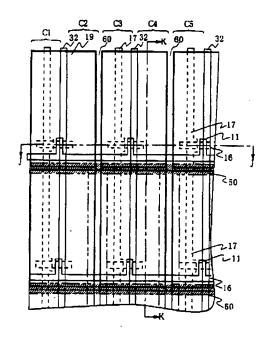
【符号の説明】

- 10 基板
- 11 ケート電極
- 12 ゲート絶縁膜
- 15 層間絶縁膜
- 16 ソース電極
- 17 ドレイン電極
- 19 表示電極
- 20 配向膜
- 30 ガラス基板
- 31 対向電極
- 32 配向制御窓
- 10 液晶
- 4.1 液晶分子
- 50 補助電極

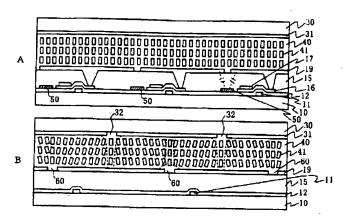
【図1】



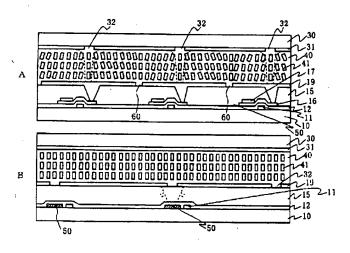
【図3】



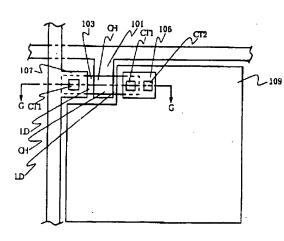
【図2】



【図4】



【図5】



[図6]

